

CD4052B

■ 产品简介

CD4052B 是一款采用先进 CMOS 技术设计的两路差分四通道多路复用器。是一个单刀四掷配置形式的模拟开关。具有两个二进制通道控制输入 (A 和 B) 以及一个使能输入 INH。两个二进制输入信号,同时控制每路开关四个通道中的一个通道开启,其余通道关闭。

■ 产品特点

- 低输入电流: I_{IN}≤1uA, @V_{IN}=V_{DD}-V_{SS}=15V, Ta=25℃
- 低静态功耗: I_{DD}=0. 2uA(典型)@V_{DD}-V_{SS}=15V, Ta=25℃
- 低通电阻: 60Ω(典型)@V_{DD}-V_{SS}=V_{DD}-V_{EE}=15V, Ta=25℃
- 通道漏电流: ±100nA(典型)@V_{DD}-V_{EE}=15V
- 宽工作电压 V_{DD}-V_{SS} 范围: 3V~15V
- 先断后通切换消除了通道重迭开启
- 单刀四掷配置形式的模拟开关
- 封装形式: DIP16 、SOP16、TSSOP16

■ 产品用途

- 模拟和数字多路复用与解复用
- 信号选通

- 数字寻址信号的逻辑电平转换
- 其它应用领域

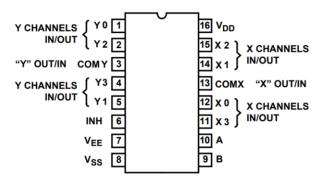
■ 产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
CD4052BE	DIP16L	CD4052B	管装	1000 只/盒
CD4052BM/TR	SOP16L	CD4052B	编带	2500 只/盘
CD4052BMT/TR	TSSOP16L	CD4052B	编带	2500 只/盘

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号	管脚定义	说明	管脚序号	管脚定义	说明
1	YO	YO 通道	16	$V_{\scriptscriptstyle DD}$	电源正
2	Y2	Y2 通道	15	Х2	X2 通道
3	COMY	Y 通道公共端	14	X1	X1 通道
4	Y 3	Y3 通道	13	COMX	X 通道公共端
5	Y1	Y1 通道	12	XO	XO 通道
6	INH	使能控制	11	Х3	X3 通道
7	V_{EE}	模拟开关负电源	10	A	地址输入 A
8	$V_{\rm SS}$	电源地	9	В	地址输入 B

DIP16/S0P16/TSS0P16



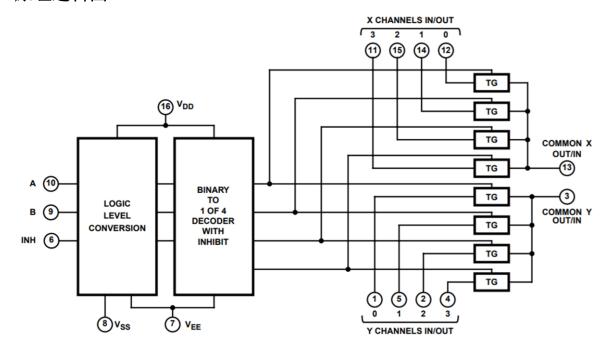


■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
直流电源电压	V_{DD} – V_{SS}	-0.5∼18	V
模拟电源电压	V_{DD} – V_{EE}	18	V
直流输入电压	V_{IN}	$-0.5+V_{SS}\sim V_{DD}+0.5V$	V
功耗	P_{D}	500	mW
工作温度	T_{A}	-40~85	$^{\circ}$
存储温度	T_s	-65-150	$^{\circ}$
引脚焊接温度	$T_{\scriptscriptstyle W}$	260, 10s	$^{\circ}$

注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 真值表

	OUTPUTS		
INH	В	A	"ON" CHANNEL (S)
0	0	0	X0, Y0
0	0	1	X1、Y1
0	1	0	X2、Y2
0	1	1	Х3, Ү3
1	×	×	None

2

×:任意值



■ 推荐工作条件

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
直流电源电压	V_{DD} – V_{SS}	3		15	V
控制输入电压	V_{IS}	0		V_{DD} - V_{SS}	V
模拟电源电压	V_{DD} – V_{EE}	0		15	V
模拟输入输出电压	V_{IN} , V_{OUT}	0		$V_{ ext{DD}} - V_{ ext{EE}}$	V
工作温度	T_{Λ}	-40		85	$^{\circ}$ C

■ 电学特性

直流电学特性: (V_{IS}=V_{IN}-V_{SS}, V_{EE}=V_{SS}, RL = 3kΩ, T_A=25℃ 除非特别指定)

且机电子行注。 (VIS-VIN-VSS, VEE-VSS, RL - 3KL2, IA-23 C 陈非行剂相比)								
符号	项目	初	则试条件	VDD (V)	最小值	典型值	最大值	单位
	宣山亚 左孙	W -W		5	3. 5			V
$V_{\rm IH}$	高电平有效	V _{IH} =V _{DD} through 1k	$V_{EE}=V_{SS}$,	10	7			V
	输入电压 through 1k	tiii Ougii Tk	RL=1k Ω to V_{SS} ,	15	11			V
	化由亚去盐	$V_{IL}=V_{DD}$	I _{IS} <2uA on all	5			1.5	V
$V_{\rm IL}$	低电平有效 输入电压	through 1k	OFF Channels	10			3	V
		tiii Ougii Tk		15			4	V
				5		155		
R_{ON}	导通电阻	$0 \leqslant V_{IS} \leqslant V_{DD}$		10		85		Ω
				15		60		
	和你選送自選中			5		15		
△Ron	相邻通道导通电阻差			10		10		Ω
	阻左			15		5		
$I_{ ext{OFF}}$	漏电流	输入输出通过	道关闭,INH=V _{DD}	18			±100	nA
$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{IN}}$	输入电流	$V_{IN}=V_{DD}$ or V_{SS}	5	18		0.01	± 0.1	uA
						0.01	5	uA
$\mathrm{I}_{\mathtt{DD}}$	静态电流	$V_{IN}=V_{DD}$ or V_{SS}	S	10		0.01	10	uA
			15		0.01	20	uA	
$C_{\scriptscriptstyle \rm IN}$	输入电容	任意输入端				5	7. 5	pF
$C_{\rm IS}$	通道输入电容					5		рF
C_{os}	输出电容					9		рF
C_{IOS}	导通电容					0.2		pF

交流电学特性: (V_{SS}=V_{EE}, Ta=25℃, tr=tf=20ns, tpd 包含 t_{PHL} t_{PLH} , 见测试方法,除非特别指定)

项目	符号	测试条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
11 +4 -<) [- 1) -	tpd	V _{IS} =V _{DD} , RL=200k, CL=50pF	5		15		ns
传输延迟时间 Signal Input to Output			10		10		ns
Signal Input to Output			15		7		ns
传输延迟时间	tpd	CL=50pF, RL=10k	5		100		ns
Address-to-Signal OUT			10		80		ns
(Channels ON or OFF)			15		50		ns

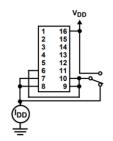


交流电学特性:	(Continues,)
	(COH CINGCO, /

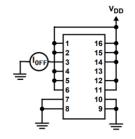
项目	符号	测试条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
传输延迟时间		C 50 F	5		100		ns
Inhibit-to-Signal OUT	tpd	$C_L=50 \mathrm{pF},$ $R_t=1 \mathrm{k}$	10		50		ns
(Channel Turning ON)		KL-1K	15		30		ns
传输延迟时间		C = FO F	5		100		ns
Inhibit-to-Signal OUT	tpd	C _L =50pF, R _l =10k	10		50		ns
(Channel Turning OFF)		KL-10K	15		30		ns

■ 测试方法

1、测试图



1 16 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10 8 9



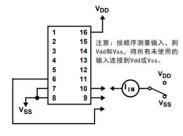
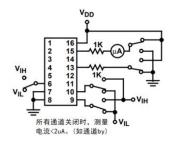


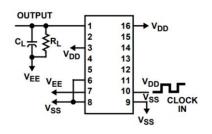
Fig.1 静态电流

Fig. 2 相邻通道关闭漏电流

Fig. 3 所有通道关闭漏电流

Fig. 4 输入电流





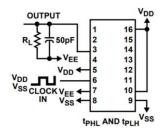


Fig. 5 输入逻辑电平电压

Fig. 6 传播延迟-通道控制输入 to 开关输出

Fig. 7 传播延迟-使能输入 to 开关输出

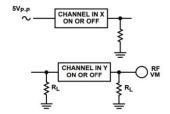


Fig. 8 相邻通道之间信号串扰

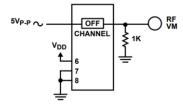


Fig. 9 所有通道关闭信号串扰

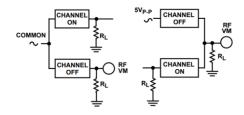
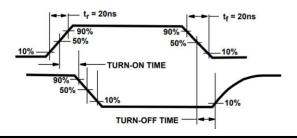
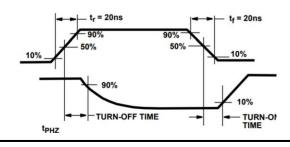


Fig. 10 同一通道信号串扰

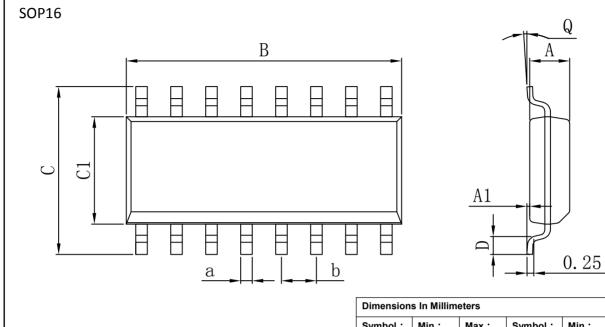
2、波形测量示意图





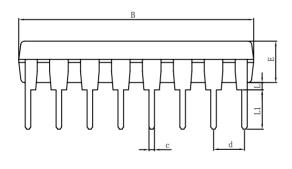


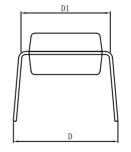
■ 封装信息

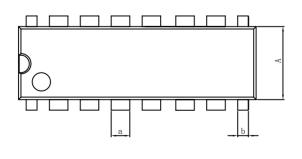


Dimensions In Millimeters							
Symbol :	Min :	Max:	Symbol :	Min :	Max:		
Α	1.225	1.570	D	0.400	0.950		
A1	0.100	0.250	Q	0°	8°		
В	9.800	10.00	а	0.420 TYP			
С	5.800	6.250	b	1.270 TYP			
C1	3.800	4.000					





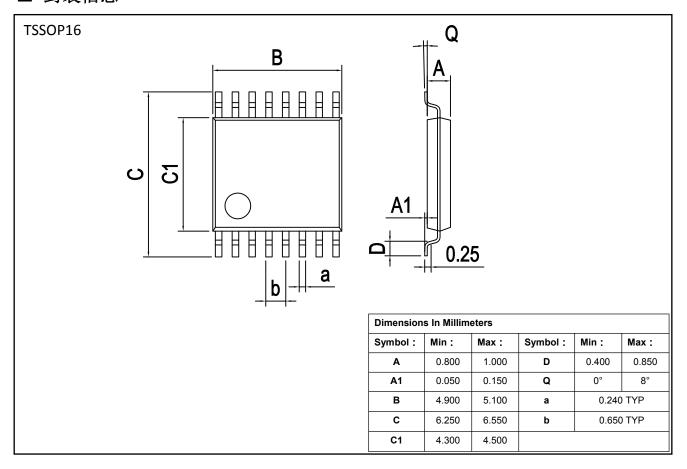




Dimensions In Millimeters							
Symbol:	Min :	Max:	Symbol:	Min:	Max:		
Α	6.100	6.680	L	0.500	0.800		
В	18.940	19.560	а	1.524 TYP			
D	8.200	9.200	b	0.889 TYP			
D1	7.42	7.820	С	0.457 TYP			
E	3.100	3.550	d	2.540 TYP			
L	0.500	0.800					



■ 封装信息





重要声明:

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。

华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。